大電流ドライブ用 シリコンNPNエピタキシァル形(ミニタイプ)

概要

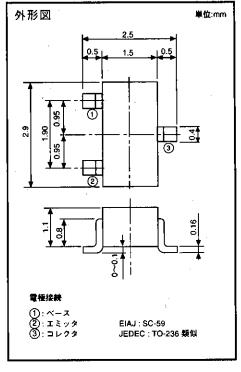
2SC3440は、超小形樹脂封止形シリコンNPNエピタキシァル形トランジスタでコレクタ電流が大きく、VCE(sat)が小さく設計、製造されております。 2SA1365とコンプリメンタリで使用できます。

特 長

- ●小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能
- ●コレクタ電流が大きい Icm∞1000mA
- ●VCE(sat)が小さい VCE(sat)=0.2V 標準
- ●直流電流増幅率の直線性が良い
- ●利得帯域幅積が高い ft=180MHz 標準

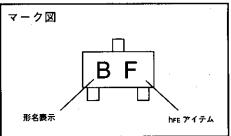
用 途

小形モータドライブ、リレードライブ、電源用



最大定格 (Ta=25℃)

記号	項	<u> </u>	定	格	値	単位	
Vсво	コレクタ・ベース	(関電圧		25		V	
VEBO	エミッタ・ベース	ス間電圧	4			٧	
VCEO	コレクタ・エミッ	タ間電圧	20		٧		
lc	コレクタ電流	=	700		mA		
СМ	せん頭コレクタ	電流	1000		mA		
Pc	コレクタ損失 (T	「a=25℃)	150		mW		
Tj	接合部温度		+125		Č		
Tsig	保存温度		-55 ~ +125			,c	



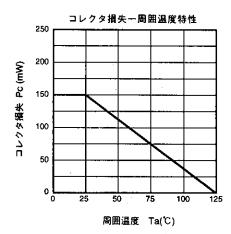
電気的特性 (Ta=25°C)

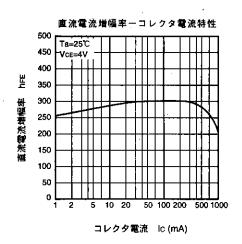
#3 B			204	<u></u>	42		特	性 値		単位
記号 項	E	測	Æ	定条	件	最小	標準	最大		
V(BR)CBO	コレクタ・ベース	降伏電圧	lc=10 μ A,lE=0mA				. 25			V
V(BR)EBO	エミッタ・ベース	降伏電圧	IE=10 μ A,Ic=0mA				4			V
V(BR)CEO	コレクタ・エミッ	夕降伏電圧	Ic=100 μ A,RBE=∞				20			V
Ісво	コレクタしゃ断1	電流	Vcs=25V,IE=0mA						1	μA
(EBO	エミッタしゃ断1	電流	VEB=2V,IC=0mA						1	μA
hfe *	直流電流増幅率		VcE=4V,lc=100mA				150		800	
VCE(eat)	コレクタ・エミッ	夕飽和電圧	Ic=500mA,IB=25mA					0.2	0.5	V
fr	利得帯域幅積		Vce=6V.le=-10mA					180		MHz

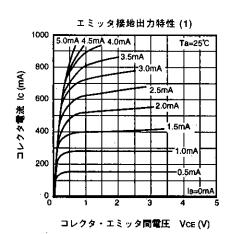
*:hFE の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

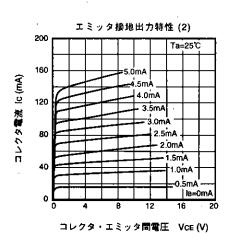
マーキング	BE	BF	BG
hFE	150 ~ 300	250 ~ 500	400 ~ 800

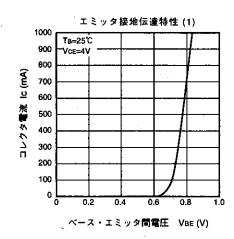
標準特性

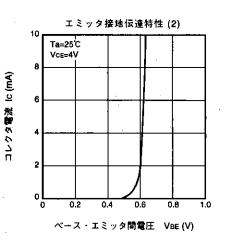












安全設計に関するお願い 一

・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

・本資料ご利用に際しての留意事項 -

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有 の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三 菱電機は特性改良などにより予告なしに変更することがあります。従って、三菱半導体製 品のご購入に当たりましては事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または特約店へご照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。